

证书号第7197004号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称：沟槽型碳化硅场效应晶体管及其制备方法

专利权人：江苏中科汉韵半导体有限公司

地址：221000 江苏省徐州市经济技术开发区创业路26号A-2厂房1F-2F

发明人：袁述;苗青

专利号：ZL 2021 1 0820925.0

授权公告号：CN 113555414 B

专利申请日：2021年07月20日

授权公告日：2024年07月16日

申请日时申请人：江苏中科汉韵半导体有限公司

申请日时发明人：袁述;苗青

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨

